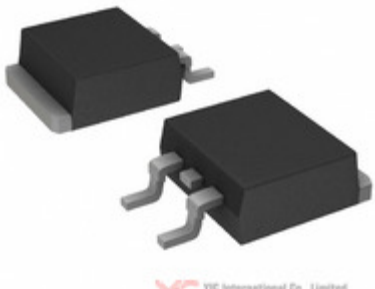











	<h2 style="color: red;">SIHD6N65ET1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIHD6N65ET1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 7A TO252AA
	Datenblätter:  SIHD6N65ET1-GE3.pdf
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHD6N65ET1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 7A TO252AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	78W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	820pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 7A (Tc) 78W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

SIHD6N65ET1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHD6N65ET1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHD6N65ET1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIHD6N65ET1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHD6N65ET4-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 7A TO252AA</p>	 <p>SIHD6N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO-252</p>	 <p>SIHD6N62E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 620V 6A TO-252</p>	 <p>SIHD7N60E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 7A TO-252</p>
 <p>SIHD7N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO-252</p>	 <p>SIHD6N65ET5-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 7A TO252AA</p>	 <p>SIHD6N65E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 7A TO252</p>	 <p>SIHD6N62ET1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 620V 6A TO252AA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHD6N65ET1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHD6N65ET1-GE3 Datenblatt	SIHD6N65ET1-GE3-Datenblätter	SIHD6N65ET1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHD6N65ET1-GE3
SIHD6N65ET1-GE3 Electronic	SIHD6N65ET1-GE3-Komponenten	SIHD6N65ET1-GE3-Verteiler	SIHD6N65ET1-GE3-Bild	SIHD6N65ET1-GE3-Teil
SIHD6N65ET1-GE3 Preis	SIHD6N65ET1-GE3 Hersteller	SIHD6N65ET1-GE3 Bild	SIHD6N65ET1-GE3 Aktie	SIHD6N65ET1-GE3 Inventar
SIHD6N65ET1-GE3 Neu	SIHD6N65ET1-GE3 Original	SIHD6N65ET1-GE3 garantiert	SIHD6N65ET1-GE3 RFQ	SIHD6N65ET1-GE3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited